METHOD OF MANUFACTURING OPTICAL INFORMATION RECORDING CARRIER

Patent number: JP2002334490 (A)

Publication date: 2002-11-22

Inventor(s): HIGUCHI TAKANOBU, IIDA TETSUYA; OGOSHI KUNIZO, YOKOZEKI SHINICHI + Applicant(s): PIONEER ELECTRONIC CORP +

Classification:

· international: G1187/24; G1187/26; G1187/24; G1187/26; (IPC1-7): G1187/24, G1187/26

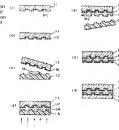
- european:

Application number: JP20020134784 20020510

Priority number(s): JP20020134784 20020510; JP19880281823 19881108

Abstract of JP 2002334490 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide method of manufacturing an optical information recording carrier which has a relatively simple structure and made higher in density suitable for mass production (at by simple process steps. SOLUTION. This method. includes the process step of forming a first reflection layer on a transparent substrate, a process step of holding a transparent stamper having radiation transmittability through a radiation curing resin on the first reflection layer, the process step of irradiating the radiation curing resin with radiation from the transparent stamper side and forming a transparent layer by curing the resin, the process step of peeling the stamper form the transparent layer, the process step of forming a second reflection layer on the transparent layer and the process step of laminating a protective layer protecting the second reflection layer thereon.



Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出級公開游号 特i期2002-334490

(P2002-334490A) (43)公開日 平成14年11月22日(2002,11,22)

(51) Int.CL7		識別配号	F 1			f-?]-}*(參考)
G11B	7/26	5 3 1	CliB	7/26	531	5 D 0 2 9
	7/24	5 2 2		7/24	522P	5D121
		5 3 8			538C	
					538Q	

審査請求 有 請求項の数1 OL (全 4 頁)

特額(2002-134784(P2002-134784)	(71)出嶼人	000000016	
特額2000-335421(P2000-335421)の		パイオニア株式会社	
分割		東京都目黒区目黒1丁目4番1号	
平成1年1月30日(1989, 1, 30)	(72)発明者	樋口 隆信	
		埼玉県館ヶ島市富士見6 丁目1番1号	八
特察附63-281823		イオニア株式会社総合研究所内	
昭和63年11月8日(1988.11.8)	(72) 発明者	飯田 村職	
日本 (JP)		埼玉県総ケ島市富士見6 5目1番1号	м
		イオニア株式会社総合研究所内	
	(72)発明者	尾越 国三	
		埼玉黒綿ケ島市富士見6 丁目1番1号	15
		イオニア株式会社総合研究所内	
	特額2000-335421(P2000-335421)の 分割 平成1年1月30日(1989, 1, 30) 特額別63-281823 昭和63年11月8日(1988, 11, 8)	特額2000-335421(P2000-335421)の 分割 平成1年1月30日(1689, 1,30) (72)発明者 特額到63-251823 昭和53字11月8日(1988, 11.8) (72)発明者 日本(JP)	特額2000-335421(P2000-335421)の 分割 平成1年1月30日(1689.1.30)

(54) 【発明の名称】 光学式情報和録担体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 比較的単純な構造を有しかつ簡素な工程にて 大量生産に適する高密度化した光学式情報記録担体の製 適方法を提供することにある。

【解決手段】 透明基既上上納1反射層を削減する工程 と、前起第1反射層上に放射線硬化樹脂を介して放射線 透過性を育する透明スクンパを保持する工程と、前記透明 明スタンパ制から放射線を前記数射線硬化樹脂や原針し たれを便化をでは適明量を粉ぐる工程と、前記透明層 から前記スクンパを剥離する工程と、前記透明層上に等 2反射線を形成する工程と、高記等り層上に等 2反射線を形成する工程と、高記等り層上に等





最終質に続く











【特許請求の劉用】

【請求項1】 透明基板上に第1反射層を形成する工程

前記第1反射褶上に放射線硬化熱脂を介して放射線透過 性を育する透明スタンパを保持する工程と、 前記透明スタンパ側から放射線を形成放射線硬化樹脂へ 照射しこれを硬化させて適明帽を形成する工程と、 前記透明原から確認スタンパを影響する工程と、

即配定の理がの報話へクジスペを制度する工程と、 前記達の実験層上に第2反射層を形成する工程と、 前記第2反射層を保護する保護層を指慮する工程と、を 合むことを特徴とする光学式情報記録担体の製造方法、

【発明の詳細な説明】

【発明の概する技術分野】本発明は、ビデオディスク. コンパクトディスク等の光ディスク、即ち光学式情記録 組体の製造方法に関する。

[0002]

【健来技術】従来から第3図(c)に示す加き光ディス が知られている。かかる光ディスクは、遮明基板上に 金属を深着かるいはスパックリングして金属に財産2が 形成され、この反射層上には処理層3が設けられている 構造を育する。透明差板上には記録すべき信号に対応す を燃か回凸(以下ビットと称する)が設けられている。この 意明率板1は、射出成形法、圧縮成形法、2 Pと法等によ って、PMMA(ポリメタアクリレート)PC(ポリカ ーポネート)等の透明態態を材料して作成されている。 【0003】第3図は光ディスクの製造工程の一関を示 している。

【0004】この製造上程においては、まず、表面に繋 施文は同心円状にビットが程列されたニッケルスタンパ (図示せず)を成形型とし、PMMA、PC等の透明樹 脂を射出成形するとにより、スタンパのビットに対応す るビットが主面に転写された透明基板1が作成される (図3(a1)

【0005】次に、第3図(b)に示す如く、真空蒸篭 工程において得られた基板1のビットPを担持した表面 上に金属反射層2が形成される。

【0006】更に、第3図(c)に示す如く、反射層2 の上に繋射線等の放射線により硬化する放射線硬化型樹 筋からなる保護機3が形成される。このようにして従来 の光ディスタが得られる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、以上の 如き光ディク製造 1器により、従来の光ディスクが多量 に製造されるのであるが、この様な資本の光ディスクで は近年におけるビットを高密度に形成して大量情報を記 替するという要望には十分こかえられなかっか。

【0008】本発明の目的は、比較的単純な構造を有しかつ簡素な工程にて大量生産に適する高密度化した光学

式情報記録担体の製造方法を提供することにある

【0009】本発明に適用される光学式情報記録担体 は、複数の反射層を透明層を介して積層したことを特徴 とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、 都昨頃1 に記載の発明は、透明趣にに第1 以見限 を形成する工程と、前記第1 定好信 上に海は線度接 を介して放射線活過性を有する透明スタンパを保持する 工程と、前記徳明スタン/報から放射線を前記放射線硬 化樹脂へ限射してれを受けることで、透明地を形成する工程と、 ・ 能記徳明樹から前記スタンパを制能する工程と、前記第2 反射層を保護する保護者を指数を指数となる工程と、前記第2 反射層を形成する工程と、を含むことを 特體を複数する記憶を報知する工程と、を含むことを 特徴をする。

[0011]

【発明の実施の影響】以下に、本発明の実施例を図面を 参昭しつつ説明する。

[0012] 第1の実験例として互いに異なる反射光帯域を持つ2つの反射管を有る光ディスクを作成する。 [0013]まず、図1(a)に示す如く、落りの配針ビットP1を配持した適明基板11を用意する。透明基板11は、その表面に頻能又は同小円球に第1の記録ビットP1が配列されたニッケルスタンバ(同形である。対比成形によりにより得られた透明成形である。対比成形により、ニッケルスタンパの配列ビットが第1ビットP1として基板1上に転写されている。

【0014】次に、第1図(b)に示す如く、真空蒸着 装置を用いてこの基板11のヒットP1を把持した表面 上に珪素(Si)を蒸着して、反射層12を形成する。 このようにして透明基板11上に珪素からなる第1反射 原12を形成する。

【0015】次に、透明スタンバ13を用象してれる味 等装置は装着する。透明スタンバ13は、次工程で塗布 される放射線硬度照射能14を硬化させるに心要な波長 帯の光を透描する放射線波過程のガラス又はプラスチッ かからなる。透明タンバ13の表面に線旋又は同心円状 に第2の記録セットが配列されており、第1面(c)に 示す如く、そのヒット面を上方に向けて転写装置に装着 する。

【0016】次に、第1図(c)に示す如く、透明スタンパ13のピット面上に、液状の放射線硬化型樹脂14を供給する。

【0017】次に、透明起版11を、その建業からなる 第1反射角12を下方に向けて液状の放棄硬化型側部1 4を介1て透明スタンパ13のヒット面に試賞する。このように、第1反射機2を必透明スタンパ13間に放 射線硬化型側部14を保持させる。(第1図(立))。 【0018】次に、第1図(d)に示す状態のままで、 スタンパ13個すなわら図面下方から放射線を照射し

て、第1反射第12上の放射線硬化型樹脂14を硬化させる。このようにして、透明スタンバ13の配列ビットを第2ビットP2として担持した硬化した放射線硬化型樹脂14上に軽等する。

【0019】次に、第1図(e)に示す如く、放射線硬化型樹脂の硬化後、この放射線硬化型樹脂14の増から 透明スタンパ13を割離する。

【00020】次に、第1図(f)に示す如く、享空業等 装置を用いて、この差板11上の放射線硬化型機能14 のビットP2を担持した実施上にアルミニかれ(A1) を蒸巻し、反射短15を形成する。このように、放射線 硬化型機能14上にアルミニウムからなる第2反射帽1 5を精震的なる。

【0021】次に、第1図(g)に示す如く、第2反射層15を保護する故事は優性型制能からなる保護層16 を積積して、反射光帯域が重いに異なる第1度が第2反 が超10万以15を誘導し、ボデュスケを得る

射層12及び15を積層した光ディスクを得る。 【0022】本実験例のように第1及び第2反射照12 及び15を建業及びアルミニウムとした場合において は、第1反射層のビットP1を読み取るときは、第1反 射層により十分反射される波長の光。例えば400 nm の光を用い、第2反射層のビットP2を読み取るとき は、第1反射層を透過しかつ第2反射層により反射され る波長の光、例えば800nm以上の光を用いる。この ように反射層を各々材質を異ならせることでその反射光 帯域を各々違う反射層とする。また、蒸落又はスパッタ リング工程において第1及び第2反射層12、15の各 層の膜厚を調整することにより、各層の光透過率を変え ることができる。さらに、図1 (a)~(f)に示す工 程を、互いに異なる反射光帯域を有する反射層材料を用 いつつ、繰り返すことによって2層以上の反射層を有す る光ディスクを得ることができる。

【0023】第2の実施例として反射光帯域が互いに異なる多数の反射層を積層した光ディスクを作成する。 【0024】まず、第2図(a)に示す如く、第1の記

【0024】まず、第2図(a)に示す如く、第1の記録ピットP1を担持した透明基板11を用窓する。透明基板11は、第1の実施側と同様のものである。

【0025] 次に、第2図(b) に示す如く、真空業業 業置を用いてこの基板11のビットP1を批替した表面 上に精電体多層反射層を形成する。このようにして透明 基板11上に第1反射光動を有する第1反射層12を 形成する。第1反射層は800nm光を反射し、他の 被長例えば600nm以下の光を透過する誘電体多層反 頻隔とする。

【10026】次に、表面に螺旋又は同心円状に第20記録セトト2分配列されたスタンパ13を、第2図(c)に示す如く、そのビット面を上方に向けて転写装置に装着する。

【0027】次に、第2図(d)に示す状態のままで、

透明基板11側すなわち図面上方から放射線を照射し

て、第1反射層12上の放射線硬化型樹脂14を硬化さ 世透明欄を形成する。このようにして、スタンバ13の 庭列ビットを第2ビットP2として担持した硬化した放 射線硬化型樹脂の透明層14上に転写する。

【0028】次に、第2図(e)に示す如く、放射線硬 化型樹脂の硬化後、この放射線硬化型樹脂の透明層14 からスタンバ13を製練する。

(10039)次に、第2図(「) に示す如く、東空樂者 装置を用いて、この基板 11上の放射線単化型機能 14 のピットP 2を選特した表面上に誘電体等層反射層 15 を形成する。このように、数射線硬化型機能 14上に算 第2反射等地域を有する第2反射制 15を管照形成する。 第2反射等域。第1反射層と繋なる疾長のレーサを反射 し、他の成長の光を造出する誘電体等極反射層 2寸を、 【0030】次に、第2回(c)に示す如く、再びスタ ンパ13によって放射線硬化型機能 14にピットを形式、 層の反射程を育する光ディスタを作成する。勿論後後の 原の反射を保護する状態が、なスタを作成する。勿論後後の を確隔して、反射光準域が加いに異なる条制。反び第2 時間 12及び15を確隔したた光デスタを得る。

【0031】各反射層で反射する波長を適当に適択する ことにより、幾く層もの反射層及び透明層を積層するこ とが可能である。

【0032】誘電体多層反射層は、PbO2、ZrO2、TlO2、外8F2、Alpo、等の高磁析率物質とSlO2、M8F2、Alpo、等の高磁析率物質の入/4限を交互に積骨することにより反射光帯域が終い反射層とすることができる。反射槽の各層の順厚を適当にずらしたり2~3の反射光帯域を同一面上で合成することにより反射光の選択性を高めることができる。

(20) 31 本実施例の場合においては、第1反射層の ピットP1を読み取るときは、第1反射により十分反射 射層のビットP1を読み取るときは、第1反射により十分反射 射層のビットP2を読みるときは、第1反射層を造過し かつ第2反射層により反射される波長の光、例えば50 の1mの光を用いる。このように、第2の実施管では、 反射光帯域が且いに異なる反射層を積層した構造を育す る光ディスクにおいて、反射層に放射線便長別脂を硬化 させることのできる被表帯像の取射を必要サーに透過す る誇電体層を用いることで、透明でない適常のスタンパ から、上型の光ディスクを作業可能としたことを特徴と している。

100341

【発明の効果】本発明によれば、反射光帯域が互いに異なる複数の反射層を種類している故に、記録密度を向上させた光学式情報記録担体が得られる。

【0035】また、本発明によれば、放射線透過性の透明スタンパを用いて該透明スタンパ制から放射線を照射

して放射継硬化型制器を硬化させ反射層を形成している 故に、複数の反射場を機屑せた光学式情報記録担体が得 われることができ、すなわち、光ディスクの大容量化が 可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光学情報記録担体の製造方法を示す機略断面図である。

【図2】本発明による光学式情報記録担体の製造方法を 示す概略勝面図である

【図3】従来の光学式情報記録担体の製造方法示す概略 断面図ある。

【符号の説明】

1 · · · 基板

12· · · 反射層

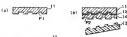
13・・・放射線透過性の透明スタンパ

14 · · · 放射線硬化型樹脂層

15、・・第2反射層

16 · · · 保護層

[図1]





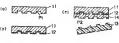








[图2]







フロントベージの統多

(72)発明者 機関 伸一 埼玉県護ヶ島市富士見6丁目1番1号 バ イオニア株式会社総合研究所内 F 夕一ム(参考) 5D029 JB13 MA18 MA19 MA33 MAC7 5D121 AA01 AA04 AA05 DD06 DD07 GG02